



# 《风光欣》技术资料

\*\*\*\*\*

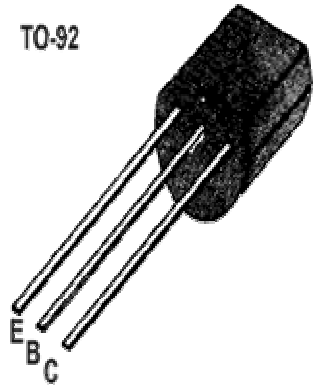
## S 9012

## PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR

主要用途:前置放大、混频、振荡等。

绝对最大额定值 (Ta=25 )

项 目	符号	额定值	单位
集电极-基极电压	V <sub>CBO</sub>	-40	V
集电极-发射极电压	V <sub>CEO</sub>	-20	V
发射极-基极电压	V <sub>EBO</sub>	-5	V
集电极电流	I <sub>c</sub>	-500	mA
集电极耗散功率	P <sub>c</sub>	625	mW
结 温	T <sub>J</sub>	150	
存储温度	T <sub>STG</sub>	-55 ~150	



电参数 (Ta=25 )

项 目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CBO</sub>	I <sub>c</sub> =-100 μ A, I <sub>E</sub> =0	-40			V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>c</sub> =-1mA, I <sub>B</sub> =0	-20			V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =-100 μ A, I <sub>c</sub> =0	-5			V
集电极-基极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = -25V, I <sub>E</sub> =0			-100	nA
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = -3V, I <sub>c</sub> =0			-100	nA
直流电流增益	h <sub>FE1</sub>	V <sub>CE</sub> = -1V, I <sub>c</sub> = -50mA	64	120	202	
	h <sub>FE2</sub>	V <sub>CE</sub> = -1V, I <sub>c</sub> = -500mA	40	90		
集电极-发射极饱和压降	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> = -500mA, I <sub>B</sub> = -50mA		-0.18	-0.6	V
基极-发射极饱和压降	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> = -500mA, I <sub>B</sub> = -50mA		-0.95	-1.2	V
基极-发射极电压	V <sub>BE(on)</sub>	V <sub>CE</sub> = -1V, I <sub>c</sub> = -10mA	-0.6	-0.67	-0.7	V

Hfe 分档及其标志

分档	D	E	F	G	H
H <sub>FE(1)</sub>	64-91	78-112	96-135	112-166	144-202